Serie 1

1:

Diferencias

BJT

- · Controlado por corriente base
- . Disp bipdar que trobaja con los cargus libres de la hicce y electrones.
- · 10 es una finción de lB
- · Bibeta factor de amplificación
- · Altas ganancias de corriente y voltage
- · Relación lineal entre 16 e 1c.

JET

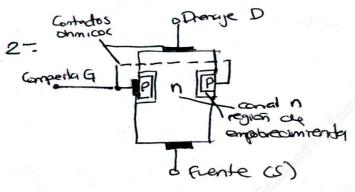
· Controlado por tención entre preste

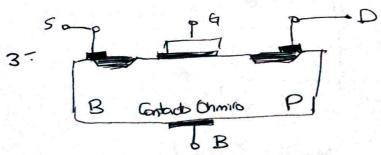
Disp Unitipolar que trabaya con las aurajus libres de los huecas (cent) p) o electrones (canal n).

-9m (factor de transconductencia)

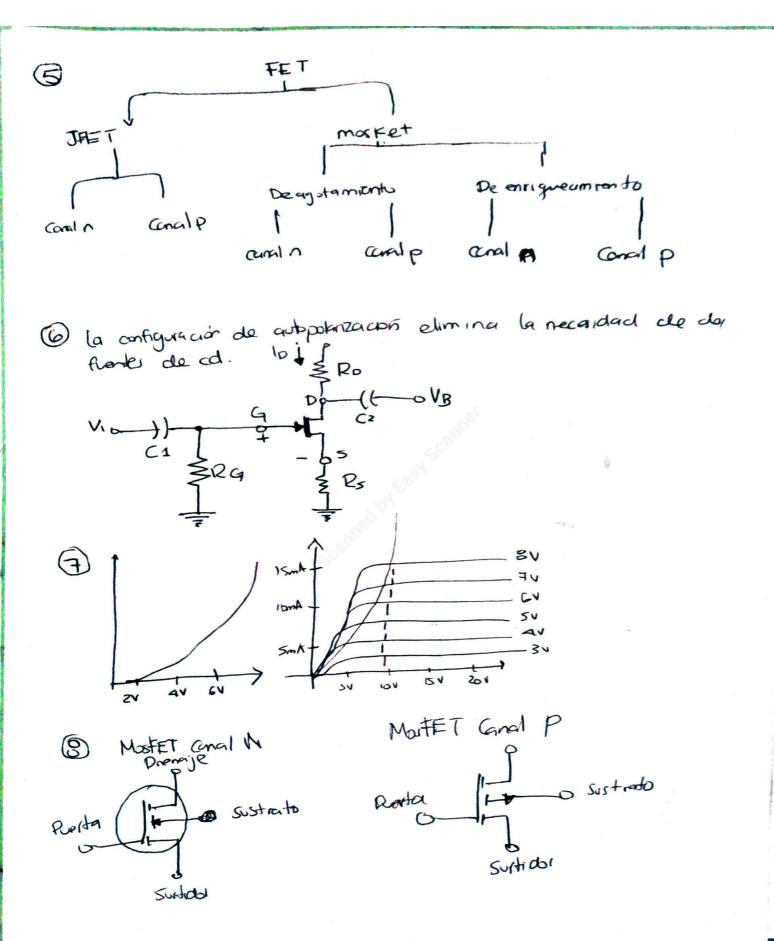
- Euranaia de comiente indefinidas 7 kg BJT de 60

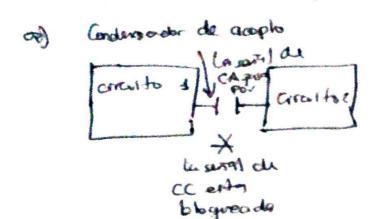
· relación accordina entre 195 eld.





4. Permite aproximar el comportamiento del diodo on mayoria de las aplicaciones. La ecacción que liga 19 intensidad de Conente y la diferences de potonical es:





voltaje. En esta región el JFET en realidad ser sequede empleur como un resistor variable cuya registencia la controla el voltaje aplica do de la sunte.

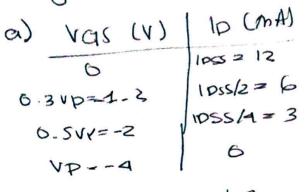
Problema 1

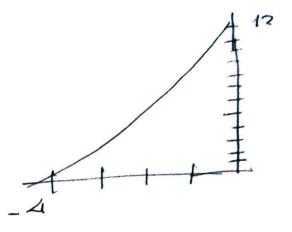
2 VGS=AV e lo (exendido) = AMA = 6V = AMA = 0.001A/V2 of 1×10-3A/V2 (0-a)2

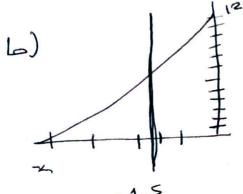
$$b = 1 \times 10^{-3} (VGS - 4)^2$$
 2
 $1 \times 10^{-3} AW$
 $1 \times 10^{-3} (VGS - 4)^2$

d)
$$Vers = -5$$
 $10 - 9mA \left(1 - \frac{-5}{-3.5}\right)^2 = 0mA$

Problema 4. Configuración de polarización







C)
$$\log = 4.7mH$$

 $VDSQ = VDD - \log PD - 3 12 - (4.7 \times 10^{-3})(1,200)$
 $VDSQ = 6.36 V$

d)
$$1DQ = 1DSS \left(1 - \frac{VGS}{VP}\right)^2 > 0.012 \left(1 - \frac{-1.5}{-a}\right)^2$$
 $1DQ = 4.6875mA$